

9097250 TOSHIBA (DISCRETE/OPTO)

39C 01920 0 T-31-23



SEMICONDUCTOR

TECHNICAL DATA

東芝トランジスタ TOSHIBA TRANSISTOR

28C2036

SILICON NPN EPITAXIAL TYPE(PCT PROCESS)★

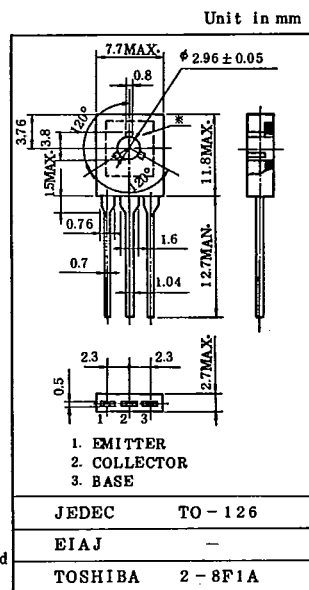
- 27MHz 高周波電力増幅用
- 27MHz RF Power Amplifier Applications
- 1Wトランシーバ送信部出力用および4Wトランシーバ
励振用として適しています。
- Recommended for 1W Mobile Radio Output
Stage and Driver Stage of 4W Transmitter

最大定格 MAXIMUM RATINGS ($T_a=25^{\circ}\text{C}$)

CHARACTERISTIC	SYMBOL	RATING	UNIT
コレクタ・ベース間電圧	V_{CBO}	80	V
コレクタ・エミッタ間電圧	V_{CER}	80	V
エミッタ・ベース間電圧	V_{EBO}	5	V
コレクタ電流	I_C	1	A
エミッタ電流	I_E	-1	A
コレクタ損失	P_C	1	W
接合温度	T_j	150	°C
保存温度	T_{stg}	-55~150	°C

注：※点線内のメタルはコレクタに接続されています。

The inside metal of dotted line is connected to collector lead.

電氣的特性 ELECTRICAL CHARACTERISTICS ($T_a=25^{\circ}\text{C}$)

CHARACTERISTIC	SYMBOL	CONDITION	MIN.	TYP.	MAX.	UNIT
コレクタシャ断電流	I_{CBO}	$V_{CB}=60V, I_E=0$	—	—	0.1	μA
コレクタシャ断電流	I_{CER}	$V_{CE}=80V, R_{BE}=220\Omega$	—	—	0.1	mA
エミッタシャ断電流	I_{EBO}	$V_{EB}=5V, I_C=0$	—	—	0.1	μA
直 流 電 流 増 幅 率	h_{FE}	$V_{CE}=2V, I_C=150mA$	100	—	—	—
コレクタ・エミッタ間飽和電圧	$V_{CE(sat)}$	$I_C=500mA, I_B=20mA$	—	—	0.7	V
ベース・エミッタ間電圧	V_{BE}	$V_{CE}=2V, I_C=500mA$	—	0.9	—	V
トランジション周波数	f_T	$V_{CE}=10V, I_C=100mA$	—	150	—	MHz
コレクタ出力容量	C_{ob}	$V_{CB}=10V, I_E=0, f=1MHz$	—	12	—	pF

★PCT技術により製造されています。

Produced by Perfect Crystal Device Technology.

TOSHIBA CORPORATION

2SC--02036-1X

105

1661

9097250 TOSHIBA (DISCRETE/OPTO)

39C 01921 D T-31-23

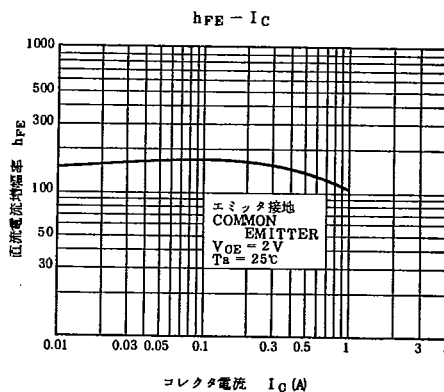
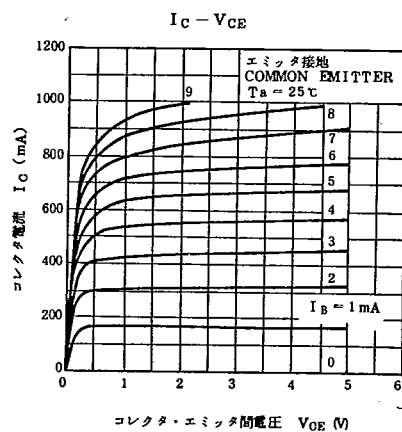
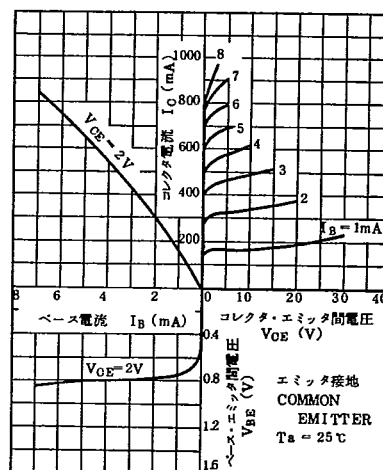


SEMICONDUCTOR

TECHNICAL DATA

2SC2036

STATIC CHARACTERISTICS



9097250 TOSHIBA (DISCRETE/OPTO)

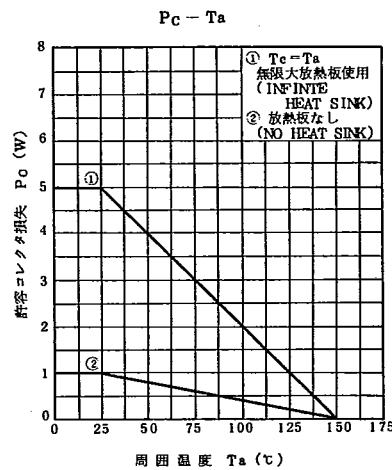
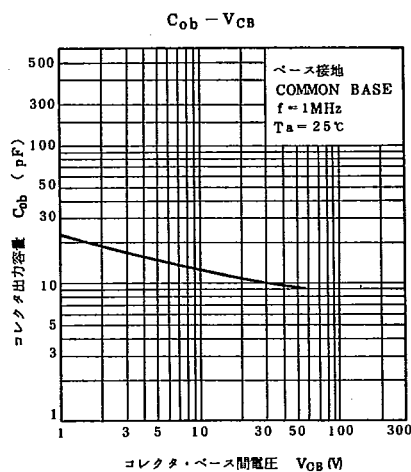
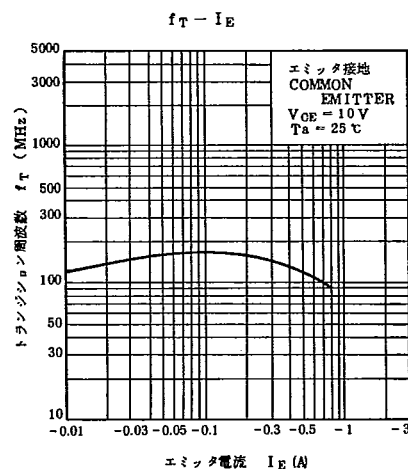
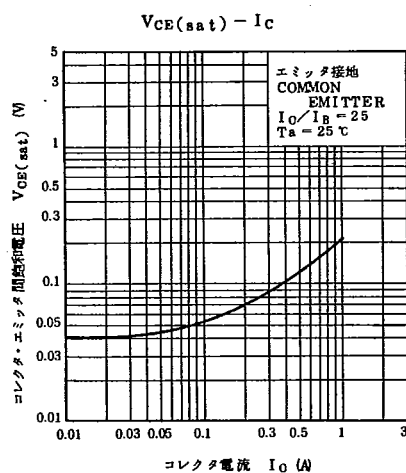
39C 01922 0 T-3123



SEMICONDUCTOR

TECHNICAL DATA

2SC2036



TOSHIBA CORPORATION

2SC--02036-3X

107

1663